

امام علی^(ع): برتری مردم به یکدیگر، به دانشها و خردهاست؛ نه به ثروت‌ها و تبارها.

۱. ملاک اصلی تمایز بین جامدات از نظر قابلیت هدایت الکتریکی کدام است؟

الف. تعداد الکترونها
ب. عرض نوار انرژی

ج. تعداد لایه‌های نوار انرژی

۲. در بلور نوع P حاملهای اکثربیت و حاملهای اقلیت هستند.

الف. حفره‌ها - الکترونها
ب. الکترونها - حفره‌ها

ج. الکترونها - حفره‌ها

۳. اگر بخار یک عنصر ۳ ظرفیتی را از روی بلور خالص Si عبور دهیم تشکیل می‌شود؟

الف. نیمه هادی نوع n

ج. نیمه هادی نوع P

۴. کدام رابطه زیر معرف جریان هدایتی در فلزات است؟

الف. $J = nq \delta E$

ج. $J = nq \mu e E$

۵. با اعمال ولتاژ معکوس به یک پیوند P-N عرض ناحیه تهی و ارتفاع سد پتانسیل چه تغییری می‌کند؟

الف. افزایش - کاهش

ج. افزایش - افزایش

۶. ولتاژ آستانه هدایت (V_0) دیود‌های سیلیکن و ژرمانیوم به ترتیب حدود ۰/۶ و ۰/۰ ولت می‌باشد. کدام یک زودتر هدایت را شروع می‌کند و کدامیک هدایت بیشتری دارد؟

الف. سیلیکن - سیلیکن

ج. ژرمانیوم - سیلیکن

ب. سیلیکن - ژرمانیوم

د. ژرمانیوم - ژرمانیوم

۷. عکس شب خط مماس بر منحنی مشخصه دیود در نقطه کار DC را چه می‌نامند؟

الف. مقاومت دینامیکی (r_d) ب. مقاومت استاتیکی (R_s) ج. ضریب هدایت

د. خط بار DC

تعداد سوالات: تستی: ۲۵
تشریحی: ۴
زمان آزمون: تستی: ۶۰ دقیقه
تشریحی: ۶۰ دقیقه
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

نام درس: الکترونیک (۱)

رشته تحصیلی و کد درس: مهندسی مدیریت اجرایی
۱۳۱۱۰.۲۰

مجاز است.

استفاده از: —

کد سری سوال: یک (۱)

۸. در یک دیود سیلیکن اگر پارامترهای نقطه کار DC به صورت ($V_D = 0/7$ V, $I_D = 10$ mA) باشد مقادیر $V_T = 26$ mV, $\eta = 2$ و Q ($V_D = 0/7$ V, $I_D = 10$ mA) چقدر است؟

ب. اهم ۵/۲ - ۷۰ اهم

الف. اهم ۷۰ - ۱۵/۲ اهم

د. اهم ۰/۱۴ kΩ - ۲/۶ اهم

ج. ۰/۱۴ kΩ - ۱۲/۶ اهم

۹. در ناحیه زنر:

الف. در بایاس معکوس اتفاق می افتد و ولتاژ متغیر و جریان ثابت است.

ب. در بایاس معکوس اتفاق می افتد و جریان متغیر و ولتاژ ثابت است.

ج. در بایاس مستقیم اتفاق می افتد و ولتاژ متغیر و جریان ثابت است.

د. در بایاس مستقیم اتفاق می افتد و ولتاژ متغیر و جریان ثابت است.

۱۰. شرط اینکه بتوان یک دیود زنر را به عنوان منبع ولتاژ با ولتاژ V_Z بکار برد کدام است؟ب. در ناحیه مستقیم بایاس شود و $V_D i_D \leq P_{D, max}$ الف. در ناحیه مستقیم بایاس شود و $I_k \leq I_Z \leq I_{Z max}$ د. در ناحیه معکوس بایاس شود و $V_D i_D \leq P_{D, max}$ ج. در ناحیه معکوس بایاس شود و $I_k \leq I_Z \leq I_{Z max}$

۱۱. در یک یکسوساز نیم موج، مقدار جریان DC تحویل شده به بار (مقاومت) کدام رابطه زیر است؟

$$\frac{V_m/\pi}{R_f + R_L} I_{dc} = d$$

$$I_{dc} = \frac{V_m}{R_f + R_L} \cdot d$$

$$I_{dc} = \frac{V_m/\pi}{R_f + R_L} \cdot d$$

$$I_{dc} = \frac{V_m}{R_f + R_L} \cdot d$$

الف. در یک دیود ایده آل: در بایاس مستقیم دیود معادل و در بایاس معکوس معادل عمل می کند.

ب. مقاومت R_d و منبع V_z الف. منبع ولتاژ V_O و منبع جریان I_s د. مقاومت R_s و مقاومت R_d

ج. اتصال کوتاه و اتصال باز

۱۲. در یک مدار کلمپ، ولتاژ خازن در ربع سیکل اول و نیم سیکل اول چگونه است؟ (V_m ماکریم دامنه ورودی است)ب. $2V_m, V_m$ الف. $V_m/2, V_m/4$ د. V_m, V_m ج. $V_m, 2V_m$

۱۳. در تحلیل یک مدار برش با ۳ دیود ایده آل حداکثر چند حالت رخ می دهد؟

د. معلوم نیست

ج. ۸ حالت

ب. ۶ حالت

الف. ۳ حالت

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۴

زمان آزمون: تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰ دقیقه

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

نام درس: الکترونیک (۱)

رشته تحصیلی و کد درس: مهندسی مدیریت اجرایی

۱۳۱۰.۲۰

مجاز است.

استفاده از: —

کد سری سوال: یک (۱)

۱۵. اگر دیودهای یک مدار دیودی ایده آل فرض شوند، کدام روش زیررا جهت تحلیل مدار انتخاب می کنید؟

- الف. روش استفاده از معادله دیود
ب. روش استفاده از منحنی مشخصه دیود
ج. روش استفاده از مدل‌های دیود
د. موارد ب و ج

۱۶. در ترانزیستورهای BJT دو قطبی کدام عامل زیر در ایجاد جریان دخالت دارد؟

- الف. حاملهای اکثربیت
ب. حاملهای اقلیت
ج. حفره ها
د. حاملهای اقلیت و اکثربیت

۱۷. اگر پیوند کلکتور-بیس در وضعیت معکوس و پیوند امیتر-بیس در وضعیت مستقیم بایاس شوند ناحیه کار ترانزیستور چیست؟

- الف. فعال
ب. فعال معکوس
ج. اشباع
د. قطع

۱۸. کدام گزینه در ناحیه اشباع صحیح نمی باشد؟(برای مدار امیتر مشترک)

$$\text{V}_{BE}(\text{on}) = 0/7 \quad \text{الف. } \text{V}_{CE}(\text{sat}) = 0/2$$

$$I_C = \beta I_B \quad \text{ج. } I_B > 0$$

۱۹. در چه ناحیه ای نامساوی $I_C < \beta I_B$ صادق است؟

- الف. اشباع
ب. فعال
ج. قطع
د. همیشه برقرار است.

۲۰. در تقویت کننده های خطی، اگر بخواهیم اعوجاج در سیگنال تقویت شده خروجی ظاهر نگردد باید چکار کنیم؟

- الف. از اشباع رفتن ترانزیستور جلوگیری کنیم
ب. از به قطع رفتن ترانزیستور جلوگیری کنیم
ج. نقطه کار DC و سطح خط بار ac انتخاب شود
د. دامنه سیگنال ورودی را محدود کنیم

۲۱. در استفاده از مدل هیبرید h تقریبی ترانزیستور با معلوم بودن کدام پارامتر هیبرید می توان بقیه پارامترها را تعیین کرد؟ (به شرط

معلوم بودن پارامترهای نقطه کار DC)

$$h_{re} \quad h_{oe} \quad h_{fe} \quad h_{ie} \quad \text{الف.}$$

۲۲. وظیفه خازن بایاس در مدار امیتر مشترک چیست؟

- الف. حذف مقاومت R_E در حالت DC
ب. حذف R_E از مدار در حالت ac
ج. حذف بایاس dc مدار
د. حذف بایاس ac مدار

استان:

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۴
 زمان آزمون: تستی: ۶۰ دقیقه
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

نام درس: الکترونیک (۱)

رشته تحصیلی و کد درس: مهندسی مدیریت اجرایی
 ۱۳۱۱۰.۲۰

مجاز است.

استفاده از:

کد سری سوال: یک (۱)

۲۳. در یک JFET کنترل جریان از طرف اعمال می گردد.

د. بایاس DC

ج. گیت

ب. درین

الف. سورس

۲۴. اگر $V_P = V_{GS}$ شود آنگاه جریان درین - سورس (I_D)

د. صفر می شود

ج. نوسان می کند

ب. زیاد می شود

الف. ثابت می ماند

۲۵. اگر بخواهیم در یک مدار FET دامنه نوسانات ماکریم شود نقطه کار را در در نظر می گیریم.

ب. بالا منحنی انتقالی

د. امکان ندارد

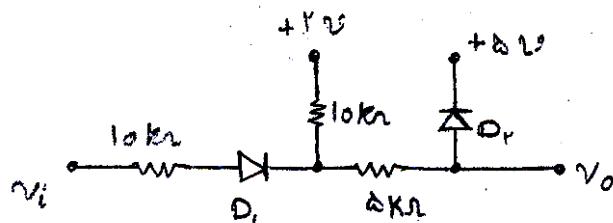
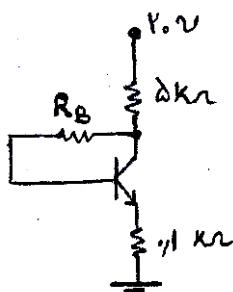
الف. وسط منحنی انتقالی

ج. پایین منحنی انتقالی

«ساختهای تشریحی»

بارم هر سوال: ۱/۵ نمره

۱. در مدار زیر با فرض ایده آل بودن دیودها، مشخصه انتقالی را محاسبه و رسم کنید.

۲. در مدار شکل زیر اگر $V_{BE(on)} = 0.7V$ و $\beta = 100$ باشد به ازاء چه مقداری از R_B ولتاژ $V_{CE} = 4V$ خواهد شد؟

استان:

تعداد سوالات: تستی: ۲۵
 تشریحی: ۴
 زمان آزمون: تستی: ۶۰ دقیقه
 تشریحی: ۶۰ دقیقه
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

نام درس: الکترونیک (۱)

رشته تحصیلی و کد درس: مهندسی مدیریت اجرایی
 ۱۳۱۰.۲۰

مجاز است.

استفاده از:

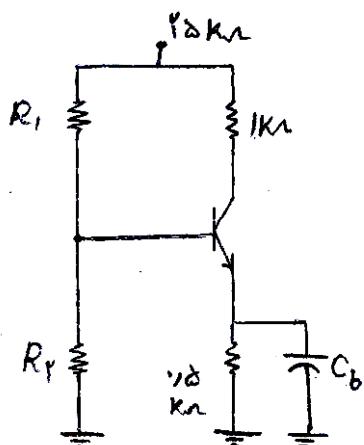
کد سری سوال: یک (۱)

۳. الف: در مدار شکل زیر R_1 , R_2 را طوری تعیین کنید که شرایط هم زمان زیر فراهم شود ($200 < \beta < 100$)

۱- دامنه نوسانات متقارن خروجی ماکزیمم شود

۲- خروجی نسبت به تغییرات β مستقل باشد

ب: خط بار ac در خط بار dc مدار را رسم کنید.

۴. در مدار شکل زیر مقادیر V , A_i , A_V و R_O را بدست آورید. (رسم مدار معادل ac و همیزی آن به همراه مراحل محاسبات الزامی(۱۰۰ = h_{fe}) $h_{ie} = 1k\Omega$ است).